

# ENJ2005-C 功率器件图示系统



## 配置规格

配置		规格/环境	
主极电压	1mV-2000V	尺寸	450×570×280 (mm)
电压分辨率	1mV	质量	35kg
主极电流	0.1nA-50A	工作电压	200V-240V
扩展电流	100A	电源频率	47Hz-63Hz
电流分辨率	0.1nA	工作温度	25°C-40°C
测试精度	0.2%+2LSB	通信接口	RS232 USB
测试速度	0.5mS/参数	系统功耗	<150w

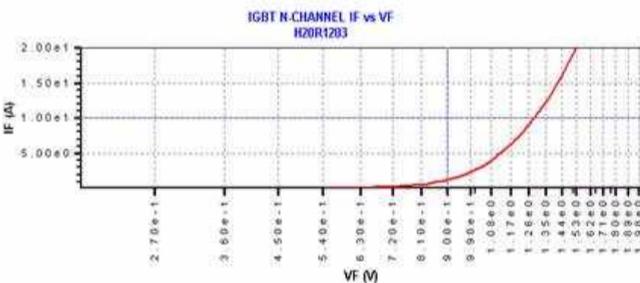
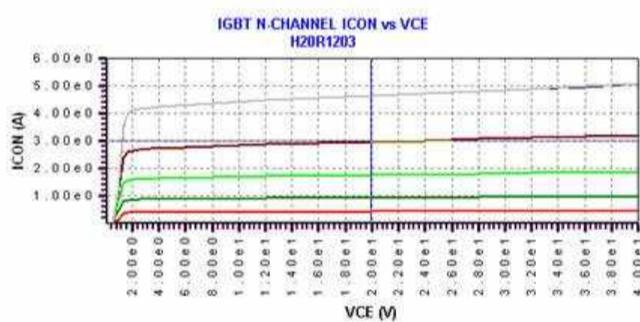
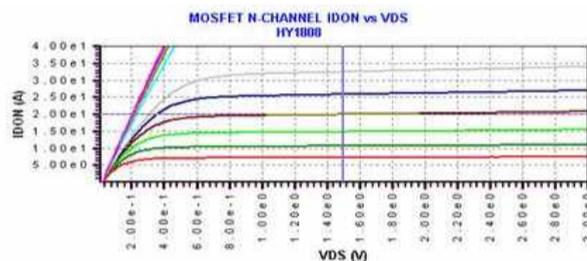
## 曲线测试

- ID vs. VDS at range of VGS
- ID vs. VGS at fixed VDS
- IS vs. VSD
- RDS vs. VGS at fixed ID
- RDS vs. ID at several VGS
- IDSS vs. VDS / HFE vs. IC
- BVCE ( O,S,R,V ) vs. IC
- BVEBO vs. IE
- BVCBO vs. IC
- VCE ( SAT ) vs. IC
- VBE ( SAT ) vs. IC
- VBE ( ON ) vs. IC ( use VBE test )
- VCE ( SAT ) vs. IB at a range of ICVf vs. IF

## 系统特征

- IV曲线显示/局部放大
- 程序保护最大电流/电压,以防损坏
- 品种繁多的曲线
- 可编程的数据点对应
- 增加线性或对数
- 可编程延迟时间可减少器件发热
- 保存和重新导入入口程序
- 保存和导入之前捕获图象
- 曲线数据直接导入到EXCEL
- 曲线程序和数据自动存入EXCEL
- 测试范围广 ( 19大类、27分类 )

## 图示例举



## 测试范围

01	二极管	/	DIODE
02	晶体管	/	NPN型/PNP型
03	J型场效应管	/	J-FET
04	MOS场效应管	/	MOS-FET
05	双向可控硅	/	TRIAC
06	可控硅	/	SCR
07	绝缘栅双极大功率晶体管	/	IGBT
08	硅触发电可控硅	/	STS
09	达林顿阵列	/	DARLINGTON
10	光电耦合	/	OPTO-COUPLER
11	继电器	/	RELAY
12	稳压、齐纳二极管	/	ZENER
13	三端稳压器	/	REGULATOR
14	光电开关	/	OPTO-SWITCH
.....	其它器件共19大类27分类		

## 测试参数

漏电参数：IR、ICBO、LCEO/S/X、IDSS/X、IDOFF、IDRM、IRRM、  
ICOFF、IDGO、ICES、IGESF、IGESR、IEBO、IGSSF、IGSSR、  
IGSS、IGKO、IR(OPTO)

击穿参数：BVCEO BVCES(300μS Pulse above 10mA)BVDSS、VD、  
BVCBO、VDRM、VRRM、VBB、BVR、VD+、VD-、BVDGO、  
BVZ、BVEBO、BVGSS、BVGKO

增益参数：hFE、CTR、gFS

导通参数：VCESAT、VBESAT、VBEON、VF、VT、VT+、VT-、VON、  
VDSON、VDON、VGSON、VF(Opto-Diode)VGSTH、VTM、  
VGETH、VSD、IDON、VSAT、IDON、VO(Regulator)  
Notch = IGT1、IGT4、ICON、VGEON、IIN(Regulator)

关断参数：VGSOFF

触发参数：IGT、VGT

保持参数：IH、IH+、IH-

锁定参数：IL、IL+、IL-

混合参数：rDSON、gFS、Input Regulation、Output Regulation

间接参数：IL

